Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

СибГУТИ

Лабораторная работа №4

Исследование переходных процессов

Вариант 4

Выполнили: студенты 2 курса группы ИП-013

Иванов.Л.Д, Клопот.А.А

Преподаватель, ведущий занятие: Гонцова Александра Владимировна

Новосибирск, 2021 г.

Цель работы: Экспериментально построить вольт-амперные характеристики (BAX) диодов и обратную ветвь BAX стабилитрона. Исследовать принцип работы параметрического стабилизатора напряжения и диодного выпрямителя.

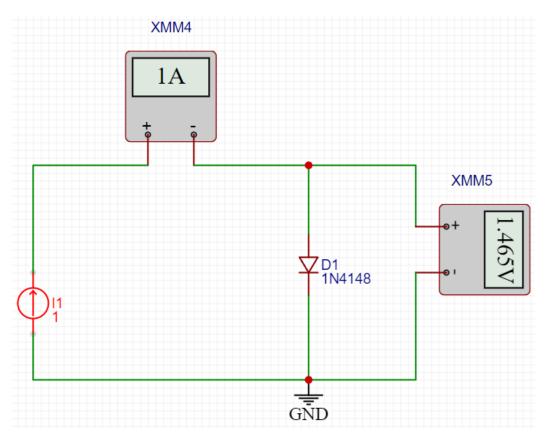
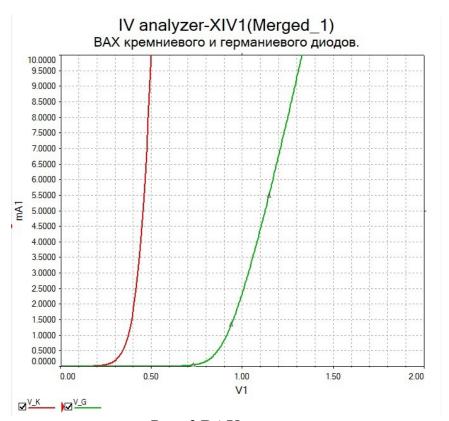


Рис. 1. Принципиальная схема исследования ВАХ диода в прямом включении

На дисплее изобразить «графопостроитель», нажав на вкладку **График XY**. По горизонтальной оси графопостроителя выбрать вольт метр **V1** с левой границей (0B), правой (+1B). По вертикальной оси выбрать миллиамперметр $\mathbf{mA1}$ с нижней границей (0 mA), верхней (+10 mA). Установить диапазон регулирования источника **E1** в пределах от (0B) до (+1B). При выборе границ и предела использовать клавиатуру компьютера.

Подсоединить проводник от + mA1 на схеме к источнику E1. Плавно поворачивая ручку управления источника E1по часовой стрелке до тех пор, пока ток mA1 по стрелочному прибору будет достигать 10mA (смотреть за красным светодиодом не допуская перегрузки). На графопостроителе должны наблюдать нарастающую по току характеристику диода похожую на стр. приложения справочных данных на полупроводниковые диоды. Для построения характеристики второго диода, необходимо нажать кнопку сброса «0» источника E1, вставить в стенд второй диод и повторить измерения характеристики.

Обе характеристики должны быть построены на одном графике. Сохранить график в заранее подготовленную папку с помощью кнопки указанной на дисплее для оформления отчёта. Определить по ВАХ какой диод германиевый, а какой кремниевый.



Puc. 2 ВАХ двух диодов

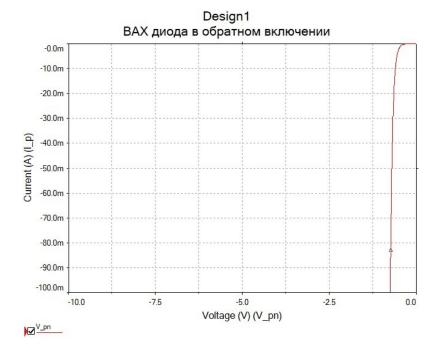
$$R_{\partial u \phi 1} = \frac{dU_1}{dI_1} = \frac{0.5B - 0.2B}{10MA - 0MA} = 30OM$$

$$R_{npgM1} = \frac{U_{np1}}{I_{np1}} = \frac{0.5 B}{9.5 MA} = 52,631 OM$$

$$R_{\partial u\phi^2} = \frac{dU_2}{dI_2} = \frac{1.35B - 0.7B}{10 \text{ mA} - 0 \text{ mA}} = 65 \text{ Om}$$

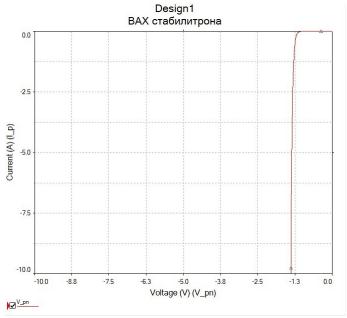
$$R_{nps_{M}2} = \frac{U_{np2}}{I_{np2}} = \frac{1.1 B}{4.5 MA} = 244,44 OM$$

Мы можем отличить диоды по их напряжению насыщения — у кремниевого диода оно больше.



 $Puc.~3~{
m BAX}$ диода при обратном включении $R_{\partial u \phi} = \frac{d~U}{dI} = \frac{-0.5 - (-0.625)}{-100~{
m MA} - (-0)} = 1.25 {
m CM}$

$$R_{np} = \frac{U_{np}}{I_{np}} = \frac{-0.625 \, B}{-10 \, \text{MA}} = 62.5 \, \text{OM}$$



Puc 4. ВАХ стабилитрона По графику можем определить Ucm = -1.125B $R_{\partial u\phi} = \frac{dU}{dI} = \frac{0 - (-1.125)B}{0 - (-10) MA} = 112.5 OM$

$$R_{\partial u\phi} = \frac{dU}{dI} = \frac{0 - (-1.125)B}{0 - (-10)MA} = 112.5 ON$$

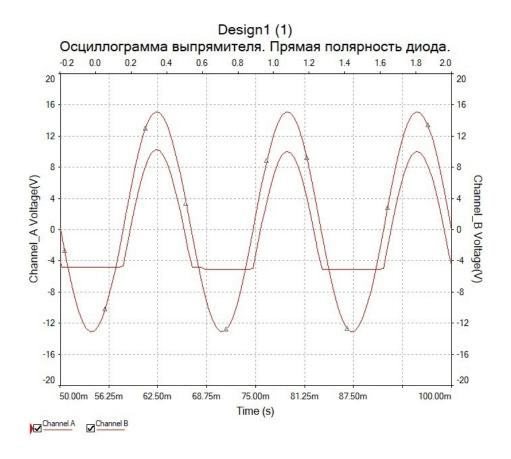


Рис 5. Осциллограмма выпрямителя. Прямая полярность диода

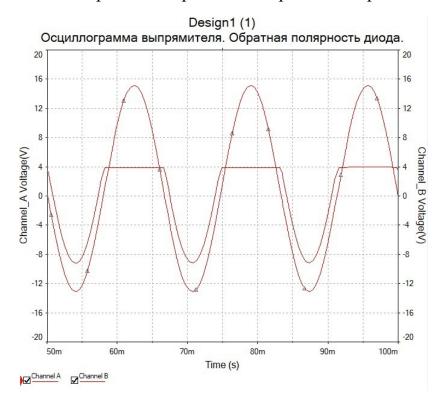


Рис 6. Осциллограмма выпрямителя. Обратная полярность диода

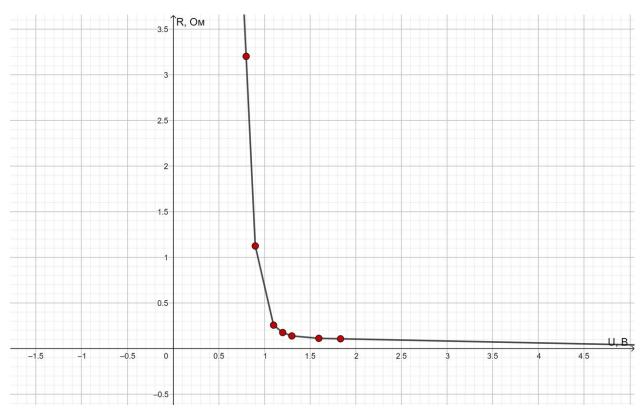


Рис. 7 График зависимости дифференциального сопротивления от напряжения на диоде

Вывод: Исследовали вольтамперные характеристики (ВАХ) полупроводниковых диодов различных типов. Сравнив кремневый и германиевый диоды мы можем сказать что насыщение у кремниевого больше германиевого. Нашли ВАХ этих диодов при прямом и обратном подключении (см. графики выше). Исследовали работу выпрямителя при прямом и обратном подключении (см. графики выше). Посчитали сопротивления для диодов и для стабилитрона. Нашли зависимость дифференциального сопротивления от напряжения на диоде, зависимость обратная. Определили напряжение стабилизации исследуемого стабилитрона. U=-1.125В Определили дифференциальное сопротивление стабилитрона в заданной рабочей точке. R=112.5 Ом